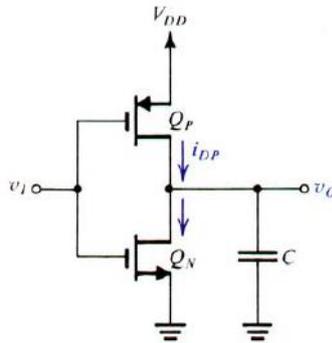


PSI3024 – Eletrônica
Terceira Lista Adicional Preparatória – 2017
GABARITO

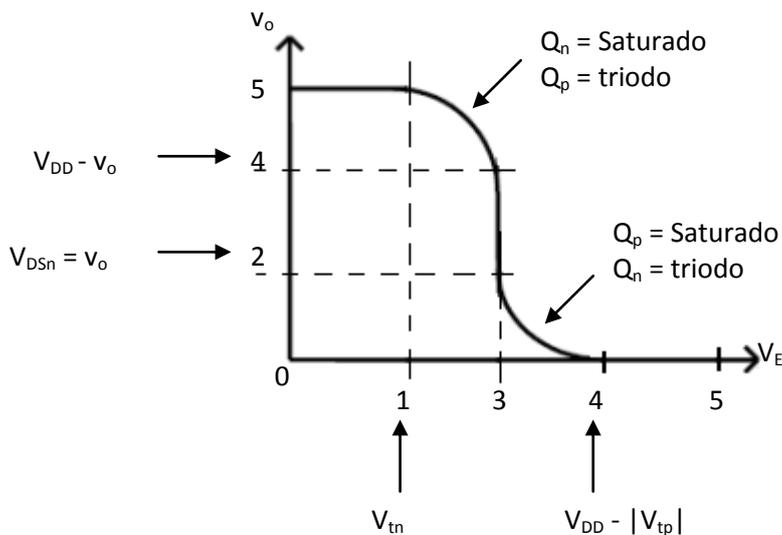
1) Dado o Inversor CMOS conforme indicado na figura abaixo e sabendo-se que $k_p' = 100\mu\text{A}/\text{V}^2$, $k_n' = 200\mu\text{A}/\text{V}^2$, $(W/L)_p = 8$, $(W/L)_n = 1$, $\lambda = 0$, $V_{DD} = 5\text{V}$, e $|V_{tp}| = |V_{tn}| = 1\text{V}$:



$$I_D = k_n' \cdot \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \quad \text{para } |V_{DS}| < |V_{GS} - V_t|$$

$$I_D = \frac{k_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad \text{para } |V_{DS}| \geq |V_{GS} - V_t|$$

Na curva de transferência:



$$|v_{DSp}| = |v_{GSp} - V_{tp}|$$

$$V_{DD} - v_o = V_{DD} - v_E - |V_{tp}|$$

$$v_o = v_E + |V_{tp}| = 3 + 1 = 4\text{V}$$

$$V_{DSn} = v_o = v_{GSn} - V_{tn}$$

a) Determine a tensão de entrada v_E para a qual ocorre a transição abrupta da tensão de saída v_o na curva de transferência $v_o \times v_E$ e esboce esta mesma curva de transferência indicando as coordenadas de todos os pontos notáveis.

$L_n = L_p$

$$\frac{1}{2} 100 \cdot 10^{-6} \cdot 8 \cdot (v_E - 5 - (-1))^2 = \frac{1}{2} 200 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot (v_E - 1)^2 \quad \Rightarrow \quad 4 \cdot (v_E - 4)^2 = (v_E - 1)^2$$

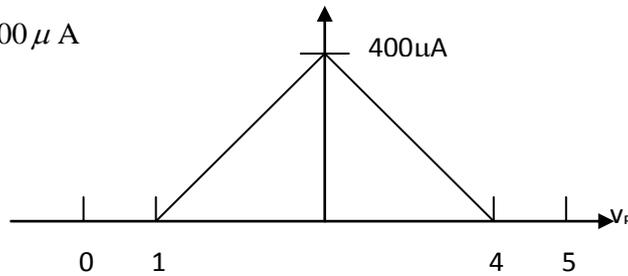
$$4(16 - 8v_E + v_E^2)^2 = v_E^2 - 2v_E + 1 \quad \Rightarrow \quad 64 - 32v_E + 4v_E^2 = v_E^2 - 2v_E + 1$$

$$3v_E^2 - 30v_E + 63 = 0 \quad v_E = \frac{30 \pm \sqrt{900 - 756}}{6} \begin{cases} v_E = 3\text{V} \\ v_E = 7\text{V} \end{cases}$$

Para transição abrupta $v_E = 3\text{V}$.

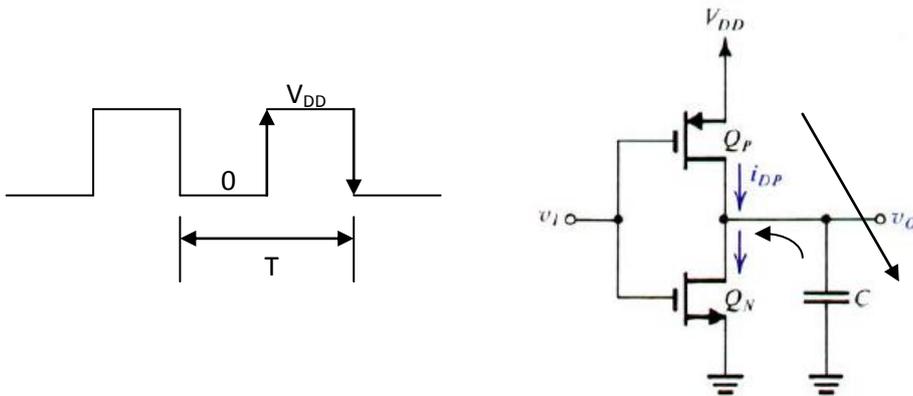
b) Determine a corrente máxima i_{Dmax} que passa através dos transistores pMOS e nMOS na transição de nível lógico e esboce o gráfico $i_D \times v_E$ indicando também todos os pontos notáveis.

$$i_{D\text{MAX}} = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot (3-1)^2 = 400 \mu\text{A}$$



c) Supondo que a capacitância C_S indicada na figura modele o efeito de todas as capacitâncias conectadas no nó de saída e admitindo que uma onda quadrada entre 0 e V_{DD} seja aplicada na entrada, deduza a expressão da potência dinâmica consumida pelo inversor CMOS. (Dica: A energia armazenada no capacitor em cada transição é igual a $C_S V^2/2$).

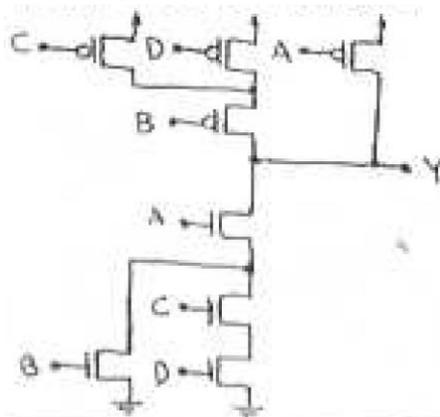
$$P_D = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot C_S \cdot f \cdot V_{DD}^2 = C_S \cdot f \cdot V_{DD}^2$$



$$E = \frac{CV^2}{2}$$

$$P_D = \left(\frac{C_L \cdot V_{DD}^2}{2} \right) \cdot 2 \cdot \frac{1}{T} \Rightarrow P_D = C_L \cdot V_{DD}^2 \cdot f$$

2) Esboce o circuito CMOS que realize a função $Y = \overline{A(B+CD)}$



3) Considere a porta lógica CMOS mostrada na figura 1. Especifique W/L para todos os transistores em termos das razões n e p do inversor básico de tal forma que t_{PHL} e t_{PLH} da porta para o pior caso sejam iguais aos do inversor básico.

Para que t_{PHL} e t_{PLH} da porta sejam iguais aos do inversor básico, para o pior caso, devemos ter:

$$P_A = P ; P_B = P_C = P_D = 2P ;$$

$$n_A = n_B = 2n ; n_C = n_D = 2(2n) = 4n.$$

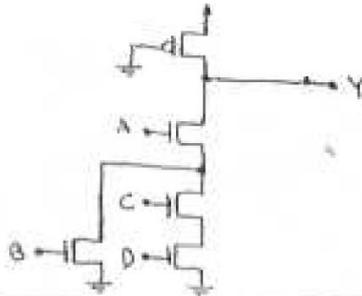
4) Projete um inversor pseudo-NMOS que tenha $V_{OL} = 0,1$ V. Sejam $V_{DD} = 2,5$ V, $|V_t| = 0,4$ V, $k'_n = 4k'_p = 120 \mu\text{A}/\text{V}^2$ e $(W/L)_n = 0,375 \mu\text{m}/0,25 \mu\text{m}$. Qual o valor de $(W/L)_p$? Calcule a dissipação de potência estática.

$$\frac{1}{2} 30 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_p (-5 - (-0,4))^2 = 120 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{0,375}{0,25}\right) \cdot \left[(5 - 0,4)0,1 - \frac{0,1^2}{2}\right] \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_p = 25,8$$

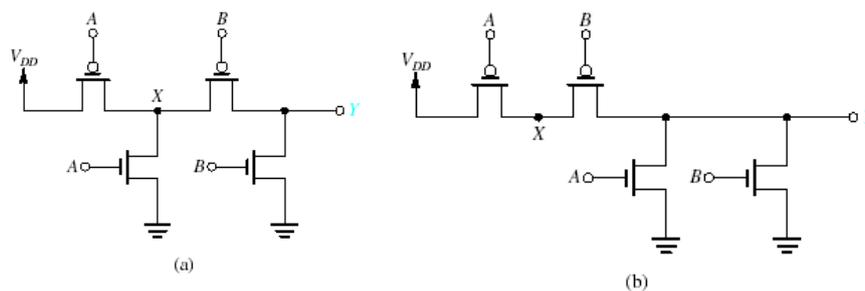
$$I_D = \frac{1}{2} 30 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_p (-5 - (-0,4))^2 = 120 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{0,375}{0,25}\right) \cdot \left[(5 - 0,4)0,1 - \frac{0,1^2}{2}\right] = 81,9 \mu\text{A}$$

$$P_{estatica} = V_{DD} I_D = 2,5 \times 81,9 \mu\text{A} = 0,205 \text{ mW}$$

5) Esboce o circuito pseudo-NMOS que realize a função $Y = \overline{A(B + CD)}$



6) Considere os circuitos da Figura 2 com todos os transistores PMOS substituídos por NMOS, e todos os NMOS por PMOS, e com as ligações do terra e V_{DD} invertidos. Quais serão as funções nas saídas Y?

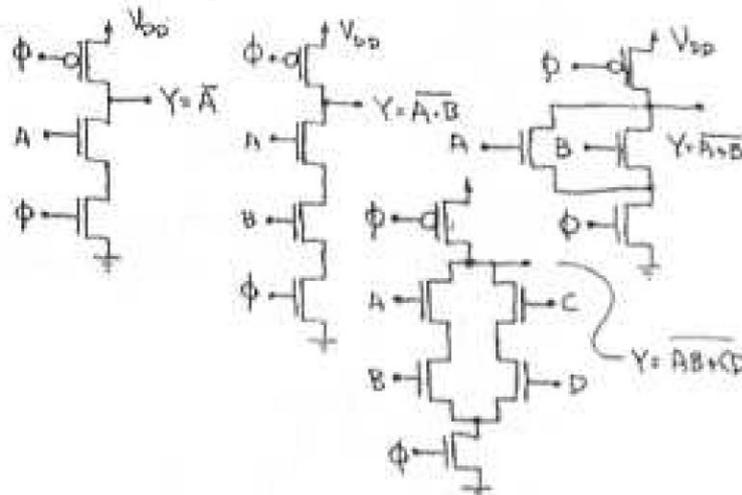


Fazendo os reversos no circuito da figura 2a, como indicado no enunciado, a saída passa a estar em nível alto quando B está em nível baixo ou quando A está em nível baixo. Nesse caso, teremos um circuito NAND:

$$Y = \overline{A + B} = \overline{AB}$$

Por outro lado, fazendo os reversos no circuito da figura 2b, como indicado no enunciado, temos idealmente uma porta NAND, antes e depois.

7) Esboce os circuitos completos para as portas INVERSORA, NE e NOU, com as duas últimas possuindo duas entradas, e um circuito para $\overline{Y} = AB + CD$.



8) Considere uma porta NE de duas entradas implementada com uma lógica dinâmica, fabricada no processo CMOS no qual $k'_n = 3k'_p = 75 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{tn} = -V_{tp} = 0,8 \text{ V}$ e $V_{DD} = 3 \text{ V}$. Para manter C_L pequeno, dispositivos NMOS de dimensões mínimas são usados com $W/L = 1,2 \mu\text{m}/0,8 \mu\text{m}$ (incluindo Q_e). O transistor de precarga Q_p possui $2,4 \mu\text{m}/0,8 \mu\text{m}$. O valor de C_L encontrado é $15 f_F$. Considere a operação de precarga com a porta de Q_p em 0 V , e suponha que em $t = 0$, C_L está totalmente descarregado. Calcule o tempo de subida para a tensão de saída, definida no tempo como sendo v_Y subindo de 10% a 90% do valor final de 3 V . Determine a corrente para $v_Y = 0,3 \text{ V}$ e a corrente em $v_Y = 2,7 \text{ V}$, então obtenha um valor aproximado para t_r , $t_r = C_L(2,7 - 0,3)/I_{av}$, onde I_{av} é o valor médio das duas correntes.

$$\text{At } v_Y = 0,3 \text{ V, } i_{DP} = \frac{1}{2} (75/3) (2,4/0,8) (3,0 - 0,8)^2 = 181,5 \mu\text{A}$$

$$\text{At } v_Y = 2,7 \text{ V, } i_{DP} = (75/3) (2,4/0,8) [(3,0 - 0,8) \cdot 0,3 - 0,3^2/2] = 46,1 \mu\text{A}$$

$$\text{Thus } i_{D_{av}} = (181,5 + 46,1)/2 = 114 \mu\text{A}$$

$$\text{and } t_{rLH} = t_r = 15 \times 10^{-15} (2,7 - 0,3) / (114 \times 10^{-4}) = 316 \text{ ps}$$

9) Explique detalhadamente os ciclos de leitura e escrita de uma célula de memória RAM estática conforme explicado em aula.

Veja itens 11.4 e 11.5 do livro.

10) Uma pastilha RAM de 256 Mbit com leitura de 16 bits emprega uma configuração de 16 blocos com conjuntos de células quadradas. Quantos bits de endereço são necessários para o bloco decodificador, o decodificador de linhas e o decodificador de colunas?

Para 16 blocos, 4 bits para endereçamento de bloco são necessários ($2^4 = 16$). Portanto, cada bloco terá 16 Mb de tamanho. Considerando a arquitetura quadrada vista em aula, cada bloco terá 4096 linhas e 4096 colunas. São necessários 12 bits para endereçamento de linha ($2^{12} = 4096$) e 12 bits para endereçamento de coluna. No total temos $2 \times 12 + 4 = 28$ bits.

11) Uma versão particular do amplificador sensor regenerativo da Figura 3 em uma tecnologia de $0,5 \mu\text{m}$, utiliza transistores para os quais $|V_t| = 0,8 \text{ V}$, $k'_n = 2,5k'_p = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$, com $(W/L)_n = 6 \mu\text{m} / 1,5 \mu\text{m}$ e $(W/L)_p = 15 \mu\text{m} / 1,5 \mu\text{m}$. Para cada inversor, obtenha o valor de G_m . Para uma capacitância da linha de bit de $0,8 \text{ pF}$ e um atraso para alcançar $0,9 V_{DD}$ de 2 ns , obtenha a tensão de diferença necessária entre as duas linhas de bit. Se o tempo puder ser aumentado de 1 ns , qual sinal de entrada poderá ser conduzido? Com o tempo de atraso aumentado e com o sinal de entrada no nível original, por qual porcentagem a capacitância da linha de bit e o correspondente comprimento da mesma podem ser aumentados? Se o tempo de atraso necessário para as capacitâncias das linhas de bit carregarem através da corrente constante disponível da célula de armazenamento for 5 ns de forma a conseguir o sinal de tensão de diferença que o amplificador sensor necessita, como esse tempo aumenta quando linhas mais longas são empregadas?

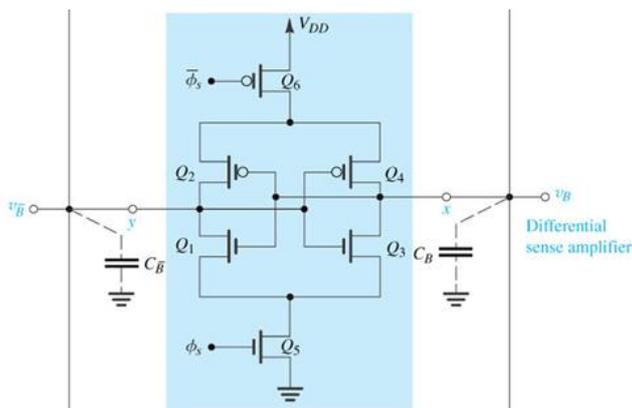


Figura 3

Pattern the solution after the approach used in the solution of Example 11.3:

For the bit-line output to reach $0.9V_{DD} = 2.7V$ from $V_{DD}/2 = 1.5V$ in $2ns$ for an initial bit-line signal of $0.1/2 = 0.05V$:

$$2.7 = 1.5 + 0.05e^{z/\tau}$$

$$\text{whence } z/\tau = \ln[(2.7 - 1.5)/0.05] = 3.178$$

$$\text{and } \tau = z/3.178 = 0.629 \mu s$$

$$\text{Thus } C/G_m = 0.629 \times 10^{-6} \text{ s, and } G_m = 1 \times 10^{-12} / (0.629 \times 10^{-6})$$

$$= 1.589 \text{ nA/V}$$

$$\text{For matched inverters, } g_{m_n} = g_{m_p} = G_m/2 = 1.589/2 = 0.795 \text{ nA/V}$$

$$\text{Now, } g_m = k'(W/L)(V_{GS} - V_t)$$

$$\text{and } 0.795 \times 10^{-3} = 100 \times 10^{-4} (W/L) [(3.0/2) - 0.8]$$

$$\text{Thus } (W/L)_n = 0.795 = 10^{-3} / (100 \times 10^{-4}) / 0.7 = 11.36$$

Now, for devices assumed to have length $L = 1 \mu m$ (or, alternatively, for each micron of device length)

$$W_n = 11.36 \mu m \text{ and } W_p = 3(11.36) = 34.1 \mu m$$

Now, for a differential input signal of $0.2V$ (and $0.1V$ on each bit-line), the response time is t , where

$$2.7 = 1.5 + 0.1e^{t/0.629}$$

$$\text{whence } t = 0.629 \ln(2.7 - 1.5)/0.1 = 1.56 \mu s$$

12) Dada uma memória ROM com 8 palavras de 4 bits. Escreva 8 números binários $B_3B_2B_1B_0$ onde B_3 é o dígito mais significativo. Converta cada dígito do número 8543859 em número binário e programe cada um deles na memória ROM fazendo $8543859 = W_7W_6W_5W_4W_3W_2W_1$ onde W_1 é o algarismo menos significativo, W_2 é o segundo algarismo significativo e assim por diante.

Veja ítem 11.6 do livro.

13) Considere o circuito conversor DA da Figura 9.39 para os casos em que $N = 2, 4$ e 8 . Qual será a tolerância, expressa em $\pm x\%$, para os resistores escolhidos possuindo o limite do erro resultante na saída sendo equivalente a $\pm 1/2$ LSB (bit menos significativo)?

Require error in MSB $\leq \frac{1}{2}$ LSB

$$\frac{V}{R} - \frac{V}{R(1 + \frac{x}{100})} \leq \frac{1}{2} \frac{V}{2^{N+1}R}$$

$$\frac{1 + \frac{x}{100} - 1}{1 + \frac{x}{100}} \leq \frac{1}{2^{N+1}} \quad \text{or} \quad \frac{x}{100} (2^{N+1} - 1) \leq 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2^{N+1} - 1} \times 100$$

$$N=2 \quad x = \underline{\underline{33.3\%}}$$

$$N=4 \quad x = \underline{\underline{6.27\%}}$$

$$N=8 \quad x = \underline{\underline{0.39\%}}$$

14) Considere o conversor AD do tipo ilustrado na figura 9.44 que utiliza uma frequência de relógio (clock) de 1MHz e tem $V_{REF} = 10V$. Sabe-se que a sua tensão de entrada analógica varia na faixa de 0 a -10V. O intervalo de tempo fixo T_1 é empregado para o contador acumular uma contagem de 2^N . Qual o intervalo de tempo necessário para o conversor AD efetuar a conversão do valor de fundo de escala de -10V? Se nessa condição, o pico de tensão na saída for de 10V, qual a constante de tempo do integrador? Após envelhecimento do resistor R, ele aumenta de 2% e C diminui de 1%, nesse caso qual será o novo valor de pico da tensão na saída do integrador? A precisão de conversão muda?

$$T_c = \frac{1}{f_{clk}} = 1\mu s$$

$$T_1 = 2^{12} T_c = \underline{\underline{4.096ms}}$$

$$T = T_1 + T_2 = T_1 \left(1 + \frac{V_A}{V_{ref}}\right) \\ = 2T_1 = \underline{\underline{8.19ms}}$$

$$V_{peak} = 10 = \frac{V_A}{\tau} T_1$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{V_A}{V_{peak}} T_1 = \underline{\underline{4.096ms}}$$

$\Delta C = -1\%$ and causes a -1% change in V_{peak}

$$\Rightarrow V_{peak} = \underline{\underline{9.9V}}$$

No : Final count does not depend on τ